

Искаженная ромбическая цепочка Изинга–Хаббарда

Б.М. Лисный

Институт физики конденсированных систем НАН Украины, ул. Свенцицкого, 1, г. Львов, 79011, Украина

E-mail: lisnyj@icmp.lviv.ua

Статья поступила в редакцию 26 мая 2010 г., после переработки 16 августа 2010 г.

Исследовано основное состояние и термодинамика искаженной ромбической цепочки Изинга–Хаббарда с учетом одноцентрового кулоновского отталкивания. Методом декорационно-итерационного преобразования получены точные результаты для свободной энергии, энтропии, теплоемкости, намагниченностей изинговской и хаббардовской подсистем, магнитной восприимчивости. В случае геометрически фрустрированной системы изучено влияние кулоновского отталкивания на основное состояние, полевую и температурную зависимости намагниченности, магнитной восприимчивости, теплоемкости. Сильное отталкивание предопределяет образование дополнительного высокотемпературного максимума теплоемкости. Независимо от наличия отталкивания температурная зависимость теплоемкости может иметь два низкотемпературных максимума.

Досліджено основний стан і термодинаміку спотвореного ромбічного ланцюжка Ізінга–Хаббарда з врахуванням одноцентрового кулонівського відштовхування. Методом декоративно-ітераційного перетворення отримано точні результати для вільної енергії, ентропії, теплоємності, намагніченостей ізінгівської і хаббардівської підсистем, магнітної сприйнятливості. У випадку геометрично фрустрованої системи вивчено вплив кулонівського відштовхування на основний стан, польову і температурну залежності намагніченості, магнітної сприйнятливості, теплоємності. Сильне відштовхування зумовлює утворення додаткового високотемпературного максимуму теплоємності. Незалежно від наявності відштовхування температурна залежність теплоємності може мати два низькотемпературні максимуми.

PACS: 75.10.Pq Спиновые цепочечные модели;
75.40.Cx Статические свойства;
75.50.Gg Ферромагнетики;
75.10.Jm Квантовые спиновые модели, включая квантовую спиновую фрустрацию.

Ключевые слова: спин-электронная цепочка, точно решаемая модель, геометрическая фрустрация, основное состояние, плато намагничивания, теплоемкость.

1. Введение

В статистической механике интерес к одномерным моделям с регулярным изменением взаимодействия между спинами или/и величины спина вызван возможностью их точного решения и применения к объяснению физических свойств сложных реальных систем. На сегодня известно много таких точно решаемых одномерных моделей с определенным типом структуры, создание которой отвечает декорированию примитивной ячейки спин-1/2 цепочки Изинга группой спинов в междоузельные позиции. Декорационные спины могут быть связаны между собой разными взаимодействиями, но с узловыми (изинговскими) спинами они связываются только взаимодействием Изинга. Для точного решения таких моделей используется декорационно-итерационное преобразование [1,2]. Примерами моделей этого типа являются такие цепочки Изинга: спин-

(1/2, $S > 1/2$) [3], ферромагнитная–ферромагнитная–антиферромагнитная [4], ромбическая [5]; цепочки Изинга–Гейзенберга, где между декорационными спинами действует взаимодействие Гейзенберга: простая [6,7], ромбическая [8,9], пилообразная [10], тетраэдрическая [11], с треугольными гейзенберговскими плакетками [12]. Эти модели позволяют изучать интересные особенности физических характеристик и эффекты: плато намагничивания на промежуточных значениях намагниченности [4–10,12], дополнительные низкотемпературные максимумы теплоемкости [3, 5–9,12], эффект геометрической фрустрации системы [5,8–12], взаимодействие между геометрической фрустрацией и квантовыми флуктуациями [8–12]. Интерес к этим особенностям и эффектам усиливает то, что они наблюдаются в реальных системах [8,13,14].

Недавно в работе [15] предложена модель, которая представляет собой декорированную мобильными электронами спин-1/2 цепочку Изинга. Это искаженная ромбическая цепочка Изинга–Хаббарда без учета одноцентрового кулоновского отталкивания электронов. В этой цепочке два мобильных электрона осуществляют квантовые перескоки между двумя междуузельными позициями, которые находятся в противоположных вершинах ромба. Спины в узлах и спины электронов связаны между собой вдоль сторон ромба взаимодействиями Изинга. Квантовые перескоки электронов определяют антиферромагнитную корреляцию между их спинами [15]. Поэтому при антиферромагнитном взаимодействии Изинга данная цепочка представляет собой геометрически фрустрированную спиновую систему, аналогично ромбической цепочке Изинга–Гейзенберга [8,9]. Цепочка Изинга–Хаббарда точно решается методом декорационно-итерационного преобразования [1,2]. Заметим, что если бы это была искаженная ромбическая цепочка Хаббарда, то ее точное решение можно было бы получить значительно более сложной процедурой лишь при определенных условиях для модельных параметров и для очень низких температур [16]. Для искаженной ромбической цепочки Изинга–Хаббарда без учета одноцентрового кулоновского отталкивания были исследованы свойства основного состояния, процессы намагничивания, температурные зависимости намагниченности, магнитной восприимчивости, теплоемкости [15], а также магнитокалорический эффект [17]. В частности, показано, что в процессе намагничивания при нуле температуры намагниченность может иметь промежуточное плато на высоте 1/3 от намагниченности насыщения, и что температурная кривая теплоемкости имеет главный и низкотемпературный второстепенный максимумы [15].

В настоящей работе исследуются свойства искаженной ромбической цепочки Изинга–Хаббарда [15] с учетом одноцентрового кулоновского отталкивания электронов. Методом декорационно-итерационного преобразования проводится точный расчет термодинамических характеристик. В случае антиферромагнитного взаимодействия Изинга, когда система геометрически фрустрирована, изучается влияние отталкивания на основное состояние, процессы намагничивания, температурные зависимости намагниченности системы, намагниченности изинговской и электронной подсистем, магнитной восприимчивости и теплоемкости.

2. Гамильтониан модели. Точный расчет термодинамических характеристик

Рассмотрим искаженную ромбическую цепочку Изинга–Хаббарда в магнитном поле [15]. Прimitivesкая ячейка цепочки (рис. 1) определяется узлами k и $k+1$, которые занимают изинговские спины. Она содержит

две междуузельные позиции $(k,1)$ и $(k,2)$, между которыми осуществляют квантовые перескоки два мобильных электрона. Между двумя электронами на одной позиции действует кулоновское отталкивание. Гамильтониан цепочки \mathcal{H} , состоящей из N примитивных ячеек, представляется в виде суммы ячейечных гамильтонианов \mathcal{H}_k :

$$\mathcal{H} = \sum_{k=1}^N \mathcal{H}_k,$$

$$\mathcal{H}_k = \sum_{\sigma \in \{\uparrow, \downarrow\}} t (c_{k,1;\sigma}^\dagger c_{k,2;\sigma} + c_{k,2;\sigma}^\dagger c_{k,1;\sigma}) + \sum_{i=1}^2 U n_{k,i;\uparrow} n_{k,i;\downarrow} + \mu_k (I_1 S_{k,1} + I_2 S_{k,2}) + \mu_{k+1} (I_2 S_{k,1} + I_1 S_{k,2}) - \frac{1}{2} h_i (\mu_k + \mu_{k+1}) - h_e (S_{k,1} + S_{k,2}), \quad (1)$$

где $c_{k,i;\sigma}^\dagger$ и $c_{k,i;\sigma}$ — операторы рождения и уничтожения электрона со спином $\sigma \in \{\uparrow, \downarrow\}$ на междуузельной позиции (k,i) , $i=1, 2$; $n_{k,i;\sigma} = c_{k,i;\sigma}^\dagger c_{k,i;\sigma}$ — оператор числа электронов со спином σ на позиции (k,i) ; $S_{k,i} = (n_{k,i;\uparrow} - n_{k,i;\downarrow})/2$ — z -компонента оператора суммарного спина электронов на позиции (k,i) . Параметры t и U означают интеграл перескока и одноцентровое кулоновское отталкивание электронов. Спиновая переменная μ_k означает z -компоненту спин-1/2 оператора и описывает состояние изинговского спина на узле k . Параметры I_1 и I_2 описывают изинговские взаимодействия вдоль сторон ромба между узловыми и междуузельными спинами примитивной ячейки, как это схематически показано на рис. 1. Параметры h_i и h_e описывают влияние магнитного поля на изинговские и электронные спины соответственно.

Найдем статистическую сумму этой системы $Z = \text{Tr} \exp(-\beta \mathcal{H})$, где $\beta = 1/k_B T$, k_B — постоянная Больцмана и T — абсолютная температура. Гамильтонианы \mathcal{H}_k коммутируют между собой, поэтому

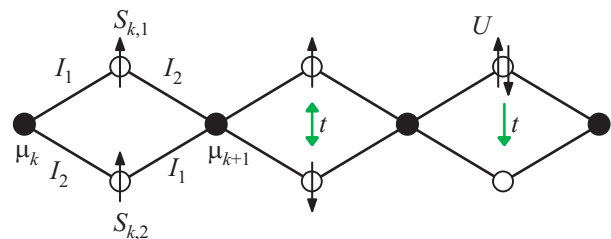


Рис. 1. Схематическое изображение фрагмента искаженной ромбической цепочки Изинга–Хаббарда. Обозначено узловые спины μ_k , μ_{k+1} и созданные двумя мобильными электронами на междуузельных позициях z -компоненты $S_{k,1}$, $S_{k,2}$ суммарных спинов.

\mathcal{Z} можно частично факторизовать:

$$\mathcal{Z} = \text{Tr}_{\{\mu\}} \prod_{k=1}^N \text{Tr}_{\{k,1;k,2\}} \exp(-\beta \mathcal{H}_k), \quad (2)$$

где $\text{Tr}_{\{\mu\}}$ — след по состояниям изинговских спинов, а $\text{Tr}_{\{k,1;k,2\}}$ — след по состояниям двух электронов ячейки k .

Рассчитаем след оператора $\exp(-\beta \mathcal{H}_k)$ по электронным состояниям:

$$\mathcal{Z}_k(\mu_k, \mu_{k+1}) = \text{Tr}_{\{k,1;k,2\}} \exp(-\beta \mathcal{H}_k).$$

Для этого переходим к матричному представлению операторов $c_{k,i;\sigma}^\dagger$ и $c_{k,i;\sigma}$ в базисе, построенном из состояний двух электронов примитивной ячейки:

$$\begin{aligned} |\uparrow, \uparrow\rangle &= c_{k,1;\uparrow}^\dagger c_{k,2;\uparrow}^\dagger |0\rangle, & |\downarrow, \downarrow\rangle &= c_{k,1;\downarrow}^\dagger c_{k,2;\downarrow}^\dagger |0\rangle, & |\uparrow, \downarrow\rangle &= c_{k,1;\uparrow}^\dagger c_{k,2;\downarrow}^\dagger |0\rangle, \\ |\downarrow, \uparrow\rangle &= -c_{k,1;\downarrow}^\dagger c_{k,2;\uparrow}^\dagger |0\rangle, & |\uparrow\downarrow, 0\rangle &= c_{k,1;\uparrow}^\dagger c_{k,1;\downarrow}^\dagger |0\rangle, & |0, \uparrow\downarrow\rangle &= c_{k,2;\uparrow}^\dagger c_{k,2;\downarrow}^\dagger |0\rangle, \end{aligned}$$

где состояния обозначены так же, как в работе [15]. В результате получаем

$$\mathcal{H}_k = h_{11} \oplus (-h_{11}) \oplus \begin{pmatrix} h_{33} & 0 & t & t \\ 0 & -h_{33} & t & t \\ t & t & U & 0 \\ t & t & 0 & U \end{pmatrix} - \frac{1}{2} h_i (\mu_k + \mu_{k+1}) \mathbf{1},$$

где

$$h_{11} = \frac{1}{2} (I_1 + I_2) (\mu_k + \mu_{k+1}) - h_e, \quad h_{33} = \frac{1}{2} (I_1 - I_2) (\mu_k - \mu_{k+1}),$$

$\mathbf{1}$ — единичная матрица. Находим собственные значения матрицы \mathcal{H}_k :

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_1(\mu_k, \mu_{k+1}) &= \frac{1}{2} (I_1 + I_2) (\mu_k + \mu_{k+1}) - h_e - \frac{h_i}{2} (\mu_k + \mu_{k+1}), \\ \mathcal{E}_2(\mu_k, \mu_{k+1}) &= -\frac{1}{2} (I_1 + I_2) (\mu_k + \mu_{k+1}) + h_e - \frac{h_i}{2} (\mu_k + \mu_{k+1}), \\ \mathcal{E}_3(\mu_k, \mu_{k+1}) &= \Lambda_1 |\mu_k - \mu_{k+1}| - \frac{h_i}{2} (\mu_k + \mu_{k+1}), \\ \mathcal{E}_4(\mu_k, \mu_{k+1}) &= \frac{1}{2} \left(U - \sqrt{U^2 + 16t^2} \right) |\mu_k + \mu_{k+1}| + \Lambda_2 |\mu_k - \mu_{k+1}| - \frac{h_i}{2} (\mu_k + \mu_{k+1}), \\ \mathcal{E}_5(\mu_k, \mu_{k+1}) &= \frac{1}{2} \left(U + \sqrt{U^2 + 16t^2} \right) |\mu_k + \mu_{k+1}| + \Lambda_3 |\mu_k - \mu_{k+1}| - \frac{h_i}{2} (\mu_k + \mu_{k+1}), \\ \mathcal{E}_6(\mu_k, \mu_{k+1}) &= U - \frac{h_i}{2} (\mu_k + \mu_{k+1}), \end{aligned} \quad (3)$$

где Λ_i — это собственные значения матрицы

$$\mathcal{L} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{I_1 - I_2}{2} & 0 \\ \frac{I_1 - I_2}{2} & 0 & 2t \\ 0 & 2t & U \end{pmatrix}.$$

В итоге получаем

$$\mathcal{Z}_k(\mu_k, \mu_{k+1}) = \sum_{i=1}^6 \exp[-\beta \mathcal{E}_i(\mu_k, \mu_{k+1})].$$

Делаем декорационно-итерационное преобразование для $\mathcal{Z}_k(\mu_k, \mu_{k+1})$ [1,2,15]:

$$\mathcal{Z}_k(\mu_k, \mu_{k+1}) = A \exp[\beta R \mu_k \mu_{k+1} + \beta h_0 (\mu_k + \mu_{k+1}) / 2],$$

где параметры преобразования A , R и h_0 определяются такими соотношениями:

$$A = \left[\mathcal{Z}_k \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) \mathcal{Z}_k \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right) \mathcal{Z}_k^2 \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right) \right]^{\frac{1}{4}},$$

$$\beta R = \ln \left[\mathcal{Z}_k \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) \mathcal{Z}_k \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right) \mathcal{Z}_k^{-2} \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right) \right],$$

$$\beta h_0 = \ln \left[\mathcal{Z}_k \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) \mathcal{Z}_k^{-1} \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right) \right].$$

Этим преобразованием вычисление статистической суммы цепочки Изинга–Хаббарда (2) сводится к вычислению статистической суммы цепочки Изинга с взаимодействием R и магнитным полем h_0 . Используя известный результат для статистической суммы цепочки Изинга [18], получаем статистическую сумму (2) в виде:

$$\mathcal{Z} = A^N (\lambda_1^N + \lambda_2^N),$$

где

$$\lambda_{1,2} = \exp\left(\frac{\beta R}{4}\right) \operatorname{ch}\left(\frac{\beta h_0}{2}\right) \pm \sqrt{\exp\left(\frac{\beta R}{2}\right) \operatorname{sh}^2\left(\frac{\beta h_0}{2}\right) + \exp\left(-\frac{\beta R}{2}\right)}.$$

Свободная энергия, которая приходится на одну примитивную ячейку, в термодинамическом пределе имеет такой вид:

$$f = -\frac{1}{\beta} \ln A - \frac{1}{\beta} \ln \lambda_1.$$

Из свободной энергии рассчитываем энтропию s и теплоемкость c :

$$s = k_B \beta^2 \left(\frac{\partial f}{\partial \beta} \right)_{h_i, h_e}, \quad c = -\beta \left(\frac{\partial s}{\partial \beta} \right)_{h_i, h_e}.$$

Расчет намагниченности $m_i = \frac{1}{2} \langle \mu_k + \mu_{k+1} \rangle$ и корреляционной функции $q_{ii}(n) = \langle \mu_k \mu_{k+n} \rangle$ изинговских спинов цепочки Изинга–Хаббарда сводится к расчету этих же характеристик для цепочки Изинга с взаимодействием R и магнитным полем h_0 . Поэтому для m_i и $q_{ii}(n)$ используем известные результаты [18]. Намагниченность электронной подсистемы $m_e = \frac{1}{2} \langle S_{k,1} + S_{k,2} \rangle$ получается дифференцированием статистической суммы \mathcal{Z} по параметру h_e [19]. Таким образом, расчет намагниченности m_e сводится к дифференцированию по h_e параметров декорационно-итерационного преобразования:

$$m_e = \frac{1}{2\beta} \left(\frac{1}{A} \frac{\partial A}{\partial h_e} + q_{ii}(1) \frac{\partial(\beta R)}{\partial h_e} + m_i \frac{\partial(\beta h_0)}{\partial h_e} \right).$$

Имея намагниченности подсистем, определяем суммарную намагниченность

$$m = (m_i + 2m_e) / 3.$$

Заметим, что в процессах намагничивания m , m_i и m_e будут иметь одинаковое значение насыщения $m_s = 1/2$.

Магнитная восприимчивость на действие магнитного поля h имеет такую структуру:

$$\chi = \frac{dm}{dh} = \frac{1}{3} \left(\frac{\partial m_i}{\partial h_i} \frac{dh_i}{dh} + \frac{\partial m_i}{\partial h_e} \frac{dh_e}{dh} \right) + \frac{2}{3} \left(\frac{\partial m_e}{\partial h_i} \frac{dh_i}{dh} + \frac{\partial m_e}{\partial h_e} \frac{dh_e}{dh} \right).$$

На этом завершаем рассмотрение основных моментов и результатов точного расчета термодинамических характеристик цепочки Изинга–Хаббарда.

3. Результаты и обсуждение

В полученных аналитических результатах изинговское взаимодействие может быть ферромагнитным или антиферромагнитным. Рассмотрим свойства цепочки в случае антиферромагнитного изинговского взаимодействия ($I_1, I_2 \geq 0$), при котором система геометрически фрустрирована. Без потери общности, примем $I_1 \geq I_2$ и введем разность изинговских взаимодействий $\Delta I = I_1 - I_2$, как это было сделано в [15]. Рассматриваем одинаковое для изинговских и электронных спинов магнитное поле $h = h_i = h_e$. Чтобы уменьшить число свободных параметров модели, перейдем, так же как в работе [15], к безразмерным параметрам:

$$\tilde{t} = \frac{t}{I_1}, \quad \tilde{U} = \frac{U}{I_1}, \quad \tilde{h} = \frac{h}{I_1}, \quad \Delta \tilde{I} = \frac{\Delta I}{I_1},$$

где $I_1 \neq 0$. Параметр $\Delta \tilde{I}$ имеет физическое содержание в области $0 \leq \Delta \tilde{I} \leq 1$ и характеризует возможную степень асимметрии изинговских взаимодействий для принятого искажения ромба.

Сначала рассмотрим свойства основного состояния системы. Основное состояние отвечает наименьшей энергии примитивной ячейки (3) при всех возможных значениях μ_k и μ_{k+1} . Энергии (3) в безразмерной форме $\tilde{\mathcal{E}}_i(\mu_k, \mu_{k+1}) = \mathcal{E}_i(\mu_k, \mu_{k+1}) / I_1$ есть функциями четырех параметров модели: \tilde{t} , \tilde{U} , $\Delta \tilde{I}$, \tilde{h} . В зависимости от этих параметров основным состоянием могут быть четыре состояния, такие же, как при отсутствии кулоновского отталкивания [15], а именно: насыщенное парамагнитное состояние SPA, ферромагнитное состояние FRI, ненасыщенное парамагнитное состояние UPA и узловое антиферромагнитное состояние NAF. Приводим безразмерные энергии этих состояний в расчете на примитивную ячейку:

$$\tilde{\mathcal{E}}_{\text{SPA}} = \frac{1}{2} (2 - \Delta \tilde{I} - 3\tilde{h}),$$

$$\tilde{\mathcal{E}}_{\text{FRI}} = \frac{1}{2} (-2 + \Delta \tilde{I} - \tilde{h}),$$

$$\tilde{\mathcal{E}}_{\text{UPA}} = \frac{1}{2} (\tilde{U} - \sqrt{\tilde{U}^2 + 16\tilde{t}^2} - \tilde{h}),$$

$$\tilde{\mathcal{E}}_{\text{NAF}} = \min\{\tilde{\Lambda}_i, i = 1, 2, 3\},$$

где $\tilde{\Lambda}_i$ — собственные значения матрицы $\tilde{\mathcal{L}} = \mathcal{L} / I_1$.
Этим состояниям отвечают такие волновые функции:

$$\begin{aligned}
 |\text{SPA}\rangle &= \prod_{k=1}^N |+\rangle_k |\uparrow, \uparrow\rangle_{k,1;k,2}, \\
 |\text{FRI}\rangle &= \prod_{k=1}^N |-\rangle_k |\uparrow, \uparrow\rangle_{k,1;k,2}, \\
 |\text{UPA}\rangle &= \prod_{k=1}^N |+\rangle_k [\Psi_{\text{UPA}}]_{k,1;k,2}, \\
 |\text{NAF}\rangle &= \prod_{k=1}^N |(-)^{n=\binom{k}{k+1}}\rangle_k [\Psi_{\text{NAF}}^{(-)^n}]_{k,1;k,2},
 \end{aligned}$$

где функции $|\pm\rangle_k$ описывают состояние изинговских спинов μ_k : $|+\rangle = |\uparrow\rangle$, $|-\rangle = |\downarrow\rangle$. Для записи волновых функций дважды вырожденного состояния NAF использовано выражение $(-)^{n=\binom{k}{k+1}}$, где выражение $(-)^n$ означает знак числа $(-1)^n$. Остальные обозначения:

$$\Psi_{\text{UPA}} = A_{\text{UPA}} (|\uparrow, \downarrow\rangle + |\downarrow, \uparrow\rangle) + B_{\text{UPA}} (|\uparrow, 0\rangle + |0, \uparrow\rangle),$$

$$\Psi_{\text{NAF}}^{\pm} = A_{\text{NAF}}^{\pm} |\uparrow, \downarrow\rangle + A_{\text{NAF}}^{\mp} |\downarrow, \uparrow\rangle + B_{\text{NAF}} (|\uparrow, 0\rangle + |0, \uparrow\rangle),$$

где

$$A_{\text{UPA}} = \frac{1}{2} \sqrt{1 + \frac{\tilde{U}}{\sqrt{\tilde{U}^2 + 16\tilde{t}^2}}}, \quad B_{\text{UPA}} = -\frac{1}{2} \sqrt{1 - \frac{\tilde{U}}{\sqrt{\tilde{U}^2 + 16\tilde{t}^2}}},$$

$$A_{\text{NAF}}^{\pm} = \frac{(\tilde{\mathcal{E}}_{\text{NAF}} \pm \frac{1}{2} \Delta \tilde{I}) (\tilde{\mathcal{E}}_{\text{NAF}} - \tilde{U})}{\sqrt{2\Phi_{\text{NAF}}}}, \quad B_{\text{NAF}} = \frac{2\tilde{t} \tilde{\mathcal{E}}_{\text{NAF}}}{\sqrt{2\Phi_{\text{NAF}}}},$$

$$\Phi_{\text{NAF}} = \left(\tilde{\mathcal{E}}_{\text{NAF}}^2 + \frac{1}{4} \Delta \tilde{I}^2 \right) (\tilde{\mathcal{E}}_{\text{NAF}} - \tilde{U})^2 + 4\tilde{t}^2 \tilde{\mathcal{E}}_{\text{NAF}}^2.$$

Рассмотрим фазовую диаграмму основного состояния в плоскости $(\Delta \tilde{I}, \tilde{h})$. Ее вид определяют параметры \tilde{t} и \tilde{U} . В зависимости от них могут реализовываться три типичные фазовые диаграммы (рис. 2), такие же, как без отгалкивания [15]. Первая типичная фазовая диаграмма (рис. 2,а) реализуется при условии

$$\tilde{t} \leq \frac{1}{4} \sqrt{1 + 2\tilde{U}}.$$

В нулевом поле состояния FRI и NAF сосуществуют при $\Delta \tilde{I} = \Delta \tilde{I}_{\text{F,N}}$, которое определяется из уравнения

$$\Delta \tilde{I}_{\text{F,N}} - 2 - 2\tilde{\mathcal{E}}_{\text{NAF}} = 0.$$

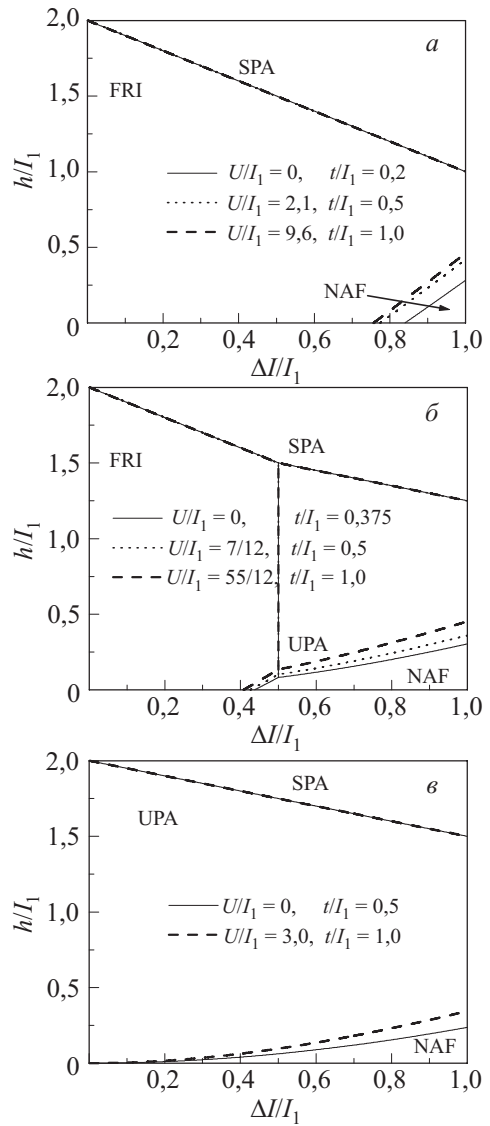


Рис. 2. Фазовая диаграмма основного состояния $(\Delta \tilde{I}, \tilde{h})$. Три возможные типичные диаграммы. На каждой диаграмме приведены линии сосуществования состояний для нескольких наборов значений параметров \tilde{U} и \tilde{t} . Результаты для случая $\tilde{U} = 0$ совпадают с соответствующими результатами работы [15].

Вторая типичная фазовая диаграмма (рис. 2,б) реализуется при условии

$$\frac{1}{4} \sqrt{1 + 2\tilde{U}} < \tilde{t} < \frac{1}{2} \sqrt{1 + \tilde{U}}.$$

Состояния FRI и UPA сосуществуют на линии $\Delta \tilde{I} = \Delta \tilde{I}_{\text{F,U}}$, где

$$\Delta \tilde{I}_{\text{F,U}} = \tilde{U} - \sqrt{\tilde{U}^2 + 16\tilde{t}^2} + 2.$$

Третья типичная фазовая диаграмма (рис. 2,в) реализуется при условии

$$\frac{1}{2} \sqrt{1 + \tilde{U}} \leq \tilde{t}.$$

Если в указанных выше соотношениях, которые характеризуют фазовую диаграмму, положить $\tilde{U} = 0$, то они совпадут с соответствующими соотношениями работы [15].

Качественное обсуждение фазовых диаграмм основного состояния на рис. 2 можно найти в работе [15]. Дополним его обсуждением интересных свойств основного состояния, выявленных в определенных случаях. Начнем с линии сосуществования состояний FRI и SPA. На этой линии также реализуется узловое антиферромагнитное состояние NAF_+ с энергией $\tilde{\mathcal{E}}_{\text{NAF}_+} = -\tilde{h}$ и волновой функцией

$$|\text{NAF}_+\rangle = \prod_{k=1}^N |(-)^{n=\binom{k}{k+1}} \rangle_{k|\uparrow, \uparrow\rangle_{k,1;k,2}}$$

Поведение изинговской подсистемы описывается такими характеристиками:

$$\beta R = \beta h_0 = 0, \quad m_i = 0, \quad q_{ii}(n) = 0. \quad (4)$$

Это свидетельствует о том, что изинговские спины являются эффективно свободными, т.е. они могут с одинаковой вероятностью находиться в двух состояниях: $|\uparrow\rangle$ и $|\downarrow\rangle$. При этом междоузельные пары электронов находятся в состоянии $|\uparrow, \uparrow\rangle$. Как известно, геометрически фрустрированные системы Изинга–Гейзенберга имеют основные состояния типа мономер–димер, в которых спины Изинга являются эффективно свободными, а пары междоузельных спинов Гейзенберга находятся в определенном запутанном состоянии, и которые называют фрустрированными состояниями (FRU) [8–10]. Пользуясь этой терминологией, данное основное состояние назовем фрустрированным ферромагнитным состоянием FRU_+ :

$$|\text{FRU}_+\rangle = \prod_{k=1}^N |\pm\rangle_k |\uparrow, \uparrow\rangle_{k,1;k,2}.$$

Состояние FRU_+ отличается от описанных в работах [8–10] фрустрированных состояний систем Изинга–Гейзенберга тем, что в нем все спины примитивной ячейки полуклассически упорядочены. Это имеет место вследствие влияния сильного магнитного поля. Эффективная свобода изинговского спина определяет макроскопическое вырождение состояния FRU_+ , которое дает остаточную энтропию $s_{\text{res}} = k_B \ln 2$.

В точке $(\Delta\tilde{I}_{\text{F|U}}, 2 - \Delta\tilde{I}_{\text{F|U}})$, где заканчивается линия сосуществования состояний FRI и SPA (рис. 2,б), состояние системы отличается от FRU_+ . В этой точке состояние изинговской подсистемы описывается такими параметрами:

$$\beta R = \beta h_0 = \ln 2, \quad m_i = \frac{m_s}{\sqrt{5}}, \quad q_{ii}(n) = \frac{1}{20} + \frac{1}{5} \left(\frac{3 - \sqrt{5}}{3 + \sqrt{5}} \right)^n.$$

Следовательно, изинговские спины не являются свободными. Такое состояние изинговских спинов при $R = h_0 = 0$ поясняется наличием в температурных зависимостях параметров R и h_0 линейной составляющей, которая влияет на формирование состояния изинговских спинов в пределе $T \rightarrow 0$. Это основное состояние имеет остаточную энтропию $s_{\text{res}} = k_B \ln[(3 + \sqrt{5})/2]$, большую, нежели состояние FRU_+ .

Рассмотрим свойства основного состояния в точке $(\Delta\tilde{I}_{\text{F,N}}, 0)$. В этом состоянии изинговские спины ведут себя свободно, согласно соотношениям (4), а состояние междоузельной пары электронов определяется состояниями соседних изинговских спинов и равновероятно может быть одним из четырех состояний: $|\uparrow, \uparrow\rangle$, $|\downarrow, \downarrow\rangle$, Ψ_{NAF}^- и Ψ_{NAF}^+ . Данное основное состояние макроскопически вырождено: $s_{\text{res}} = k_B \ln 2$. Это состояние во многом сходно с фрустрированными состояниями из работ [8–10] и состоянием FRU_+ . Однако, в отличие от этих состояний, оно не является состоянием типа мономер–димер. Такие же по сути свойства, как в точке $(\Delta\tilde{I}_{\text{F,N}}, 0)$, основное состояние имеет и в точке сосуществования состояний FRI, UPA и NAF $(\Delta\tilde{I}_{\text{F|U}}, \tilde{h}_{\text{F|N|U}})$, где $\tilde{h}_{\text{F|N|U}} = \Delta\tilde{I}_{\text{F|U}} - 2 - 2\tilde{\mathcal{E}}_{\text{NAF}}$.

Свободное поведение изинговских спинов в точках $(\Delta\tilde{I}_{\text{F,N}}, 0)$ и $(\Delta\tilde{I}_{\text{F|U}}, \tilde{h}_{\text{F|N|U}})$ исчезает при их совпадении, которое возможно только в точке $(0, 0)$ при $\tilde{t} = \sqrt{1 + \tilde{U}}/2$ (рис. 2,в). В этом случае характеристики изинговской подсистемы следующие:

$$\beta R = 2 \ln 2, \quad \beta h_0 = 0, \quad m_i = 0, \quad q_{ii}(n) = \frac{1}{4} \frac{1}{3^n}.$$

Наличие в этом основном состоянии ферромагнитной корреляции между изинговскими спинами обусловлено линейной составляющей в температурной зависимости параметра R . Это состояние имеет остаточную энтропию $s_{\text{res}} = k_B \ln 3$.

При $\tilde{t} > \sqrt{1 + \tilde{U}}/2$ в точке $(0, 0)$ реализуется фрустрированное состояние FRU :

$$|\text{FRU}\rangle = \prod_{k=1}^N |\pm\rangle_k [\Psi_{\text{UPA}}]_{k,1;k,2}.$$

В этом состоянии пара междоузельных электронов находится в запутанном состоянии, аналогично паре спинов Гейзенберга в фрустрированных состояниях систем Изинга–Гейзенберга [8–10]. Остаточная энтропия равна $k_B \ln 2$.

Теперь рассмотрим влияние кулоновского отталкивания \tilde{U} на фазовую диаграмму $(\Delta\tilde{I}, \tilde{h})$. Отталкивание \tilde{U} влияет на нее вместе с перескоками \tilde{t} через изменение энергий $\tilde{\mathcal{E}}_{\text{UPA}}$ и $\tilde{\mathcal{E}}_{\text{NAF}}$. Если изменение \tilde{U} сопровождать изменением \tilde{t} для выполнения условия неизменности энергии $\tilde{\mathcal{E}}_{\text{UPA}}$, то перестройка фазовой диаграммы $(\Delta\tilde{I}, \tilde{h})$ будет существенно проще. В частности, линия сосуществования основных состояний

FRI и UPA не изменит своего положения $\Delta\tilde{I}_{F|U}$. Привязав значение энергии $\tilde{\mathcal{E}}_{\text{UPA}}$ в этом режиме к точке ($\tilde{t} = \tilde{t}^*, \tilde{U} = 0$), где \tilde{t}^* — интеграл перескока в теории без отталкивания, получаем условие для изменения \tilde{U} :

$$\sqrt{\tilde{U}^2 + 16\tilde{t}^2} - \tilde{U} = 4\tilde{t}^*. \quad (5)$$

Влияние \tilde{U} в режиме (5) на фазовую диаграмму ($\Delta\tilde{I}, \tilde{h}$) показано на рис. 2, где в каждом из трех случаев (а, б и в) наборы параметров \tilde{U} и \tilde{t} удовлетворяют условию (5) с определенным \tilde{t}^* . При таком влиянии не изменяется заданный параметром \tilde{t}^* типичный вид фазовой диаграммы, а лишь несколько смещаются линии сосуществования состояния NAF с состояниями FRI и UPA. В этом смысле диаграммы для всех пар \tilde{U} и \tilde{t} , которые посредством соотношения (5) отвечают одному \tilde{t}^* , эквивалентны между собой. Используя это обстоятельство, строим диаграмму (\tilde{t}, \tilde{U}), которая отображает влияние отталкивания и перескоков на фазовую диаграмму ($\Delta\tilde{I}, \tilde{h}$). Диаграмма (\tilde{t}, \tilde{U}) представлена на рис. 3. Она покрыта «эквидиаграммными» линиями (5). На этой диаграмме легко увидеть, что увеличение \tilde{U} при фиксированном \tilde{t} изменяет фазовую диаграмму, аналогично как уменьшение \tilde{t} при фиксированном \tilde{U} . Это означает, что влияние отталкивания на основное состояние состоит в эффективном ослаблении влияния интенсивности перескоков.

Переходим к изучению влияния отталкивания на полевую и температурную зависимости термодинамических характеристик. С этой целью рассмотрим изменения термодинамических характеристик при изменении отталкивания в режиме (5) сравнительно с результатами работы [15]. Рассматриваем наборы значений \tilde{U} и \tilde{t} , для которых фазовая диаграмма основ-

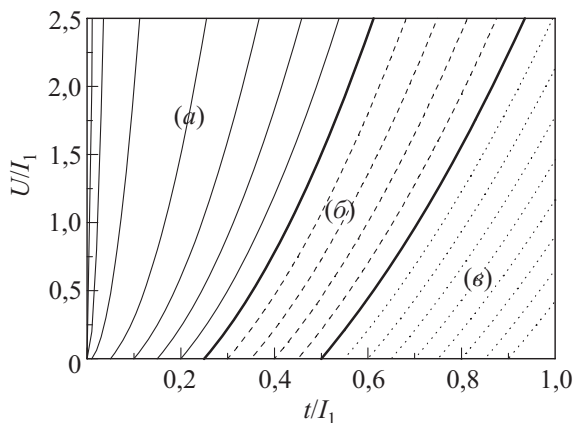


Рис. 3. Диаграмма влияния перескоков и отталкивания (\tilde{t}, \tilde{U}) на вид фазовой диаграммы основного состояния ($\Delta\tilde{I}, \tilde{h}$). (а), (б), (в) обозначают области существования изображенных на рис. 2 типов фазовой диаграммы ($\Delta\tilde{I}, \tilde{h}$). Области покрыты «эквидиаграммными» линиями: тонкими сплошными (а), штриховыми (б) и пунктирными (в). Границы между областями изображены толстыми сплошными «эквидиаграммными» линиями.

ного состояния показана на рис. 2,б. Начнем с процесса намагничивания при низких температурах. Влияние отталкивания зависит от того, какое состояние, FRI или NAF, является основным в нулевом поле. В случае основного состояния FRI влияния отталкивания практически не видно (рис. 4,а), а в случае основного состояния NAF оно проявляется существенно (рис. 5,а). Это обстоятельство связано с тем, что рост отталкивания увеличивает значение критического поля, при котором плато нулевой намагниченности переходит в плато 1/3 намагниченности насыщения (рис. 5,а). В результате этого кривая намагничивания при температуре 0.05 для $\tilde{U} = 55/12$, в отличие от $\tilde{U} = 0$ [15], демонстрирует размытие плато нулевой намагниченности (рис. 5,а). Увеличение полевого промежутка с нулевой намагниченностью отражается также на поведении низкотемпературных кривых намагниченности при соответствующих магнитных полях (рис. 5,б).

Независимо от того, какое основное состояние реализуется в нулевом поле, увеличение отталкивания смещает высокотемпературную суммарную намагниченность вверх (рис. 4,б и рис. 5,б). Чтобы понять механизм этого смещения, рассмотрим температурную зависимость намагниченностей изинговской и электронной подсистем (рис. 6). Обнаруживается, что при увеличении отталкивания высокотемпературные кривые намагниченности этих подсистем испытывают противоположные смещения: высокотемпературная кривая намагниченности изинговской подсистемы смещается вниз (рис. 6,а), а высокотемпературная кривая намагниченности электронной подсистемы — вверх (рис. 6,б). Поскольку электронная подсистема вдвое больше изинговской, она определяет направление смещения высокотемпературной суммарной намагниченности. Анализ числовых результатов показал, что это уменьшение высокотемпературной намагниченности изинговских спинов связано с уменьшением эффективного магнитного поля h_0 . Увеличение же высокотемпературной намагниченности электронной подсистемы может быть объяснено увеличением по крайней мере двух высоких энергий в спектре гамильтониана \mathcal{H}_k (3), которым отвечает нулевая намагниченность междоузельной пары электронов, а именно \mathcal{E}_5 и \mathcal{E}_6 .

Если асимметрия изинговских взаимодействий $\Delta\tilde{I}$ попадает в определенную окрестность критической точки $\Delta\tilde{I}_{F,N}$, или в область основного состояния NAF, то низкотемпературные кривые магнитной восприимчивости, умноженной на температуру ($\chi k_B T$), в нулевом поле испытывают существенные изменения под влиянием отталкивания (рис. 7). Эти изменения могут быть связаны с уменьшением энергии основного состояния NAF при росте отталкивания, аналогично изменению кривых намагничивания. Высокотемпературные кривые $\chi k_B T$ при увеличении отталкивания смещаются в область более высоких значений.

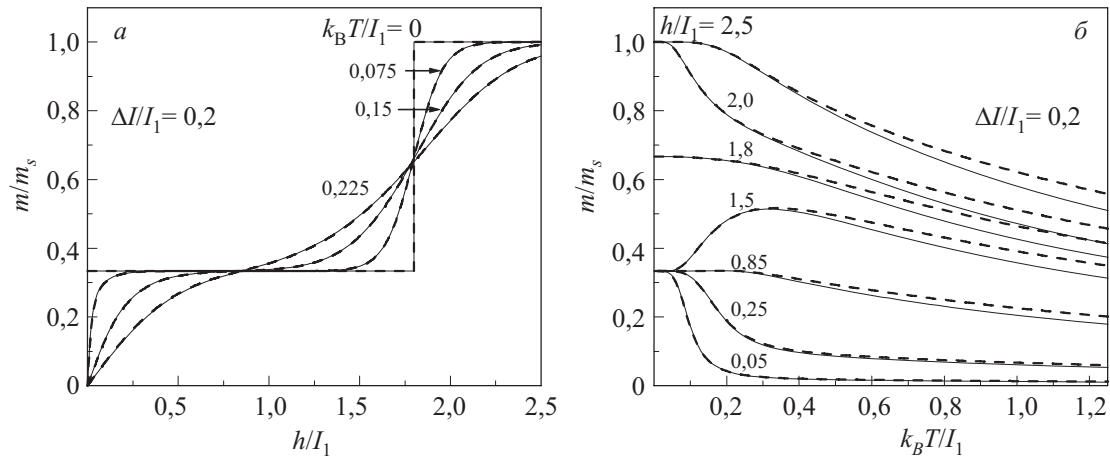


Рис. 4. Суммарная намагниченность в зависимости от магнитного поля при разных температурах (а) и от температуры при разных магнитных полях (б) для случая, когда состояние FRI является основным в нулевом поле. Сплошными линиями изображены результаты при $\tilde{U} = 0$ и $\tilde{i} = 0,375$, которые совпадают с соответствующими результатами работы [15]. Штриховыми линиями изображены результаты при $\tilde{U} = 55/12$ и $\tilde{i} = 1,0$.

Рассмотрим влияние отталкивания на температурную зависимость теплоемкости в нулевом поле. При $\tilde{U} = 0$ в этой зависимости было обнаружено два максимума [15]: главный и ближе к нулю температуры второстепенный (рис. 8), появление которого связывалось с тепловыми возбуждениями, ответственными за переходы между состояниями FRI и NAF. При $\tilde{U} = 55/12$, в отличие от $\tilde{U} = 0$, высокотемпературная зависимость теплоемкости на рис. 8 имеет главный максимум ощутимо меньшей высоты и дополнительно очень широкий низкий максимум при значительно более высокой температуре, чем температура главного

максимума. Этот дополнительный максимум возникает только при сильном отталкивании. При $\tilde{U} = 7/12$ он еще не возникает, лишь перестраивается главный максимум: понижается, расширяется и несколько смещается к более высоким температурам. Все это указывает на то, что главный максимум связан не только с теми тепловыми возбуждениями, которые разрушают вызванные наибольшим изинговским взаимодействием I_1 димеро-подобные антиферромагнитные корреляции между изинговскими и электронными спинами [15], но и с теми тепловыми возбуждениями, которые разрушают антиферромагнитные корреляции между спинами

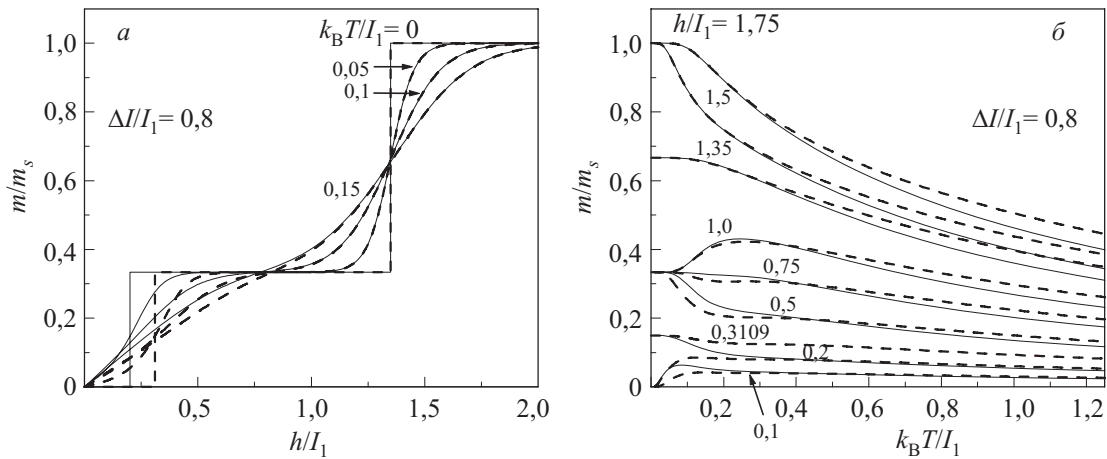


Рис. 5. Суммарная намагниченность в зависимости от магнитного поля при разных температурах (а) и от температуры при разных магнитных полях (б) для случая, когда состояние NAF является основным в нулевом поле. Сплошными линиями изображены результаты при $\tilde{U} = 0$ и $\tilde{i} = 0,375$, которые совпадают с соответствующими результатами работы [15]. Штриховыми линиями изображены результаты при $\tilde{U} = 55/12$ и $\tilde{i} = 1,0$.

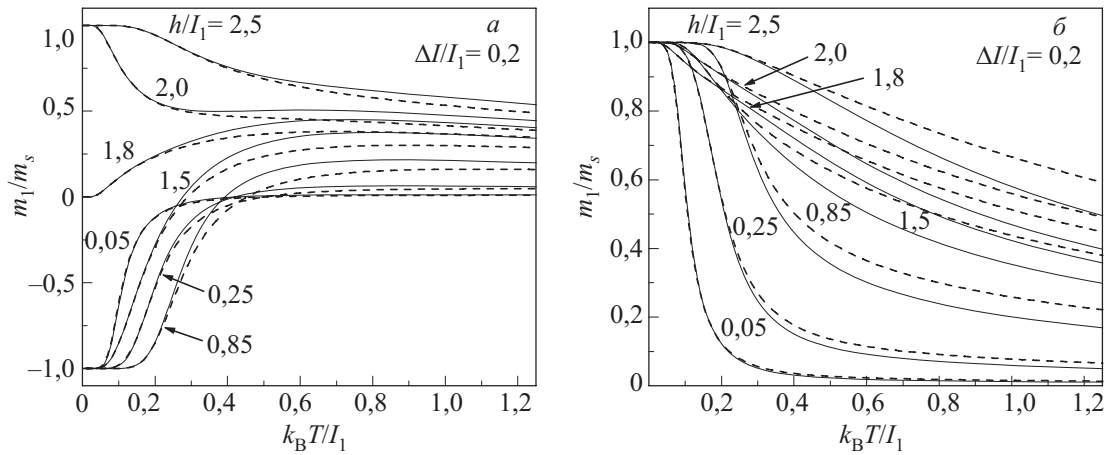


Рис. 6. Намагниченности изинговской (а) и электронной (б) подсистем в зависимости от температуры при разных магнитных полях. Эти намагниченности формируют суммарную намагниченность на рис. 4,б. Сплошными линиями изображены результаты при $\tilde{U} = 0$ и $\tilde{t} = 0,375$. Штриховыми линиями изображены результаты при $\tilde{U} = 55/12$ и $\tilde{t} = 1,0$.

междоузельной пары электронов, и которые преодолевают однопозиционное кулоновское отталкивание электронов. При изменении отталкивания низкотемпературная часть теплоемкости, которая включает второстепенный максимум, в случае принадлежности $\tilde{\Delta I}$ области основного состояния FRI практически не изменяется (рис. 8,а), а в случае принадлежности $\tilde{\Delta I}$ области основного состояния NAF существенно изменяется (рис. 8,б).

Низкотемпературная теплоемкость в нулевом поле, кроме структуры с одним второстепенным максимумом (рис. 8), может иметь структуру с двумя второстепенными

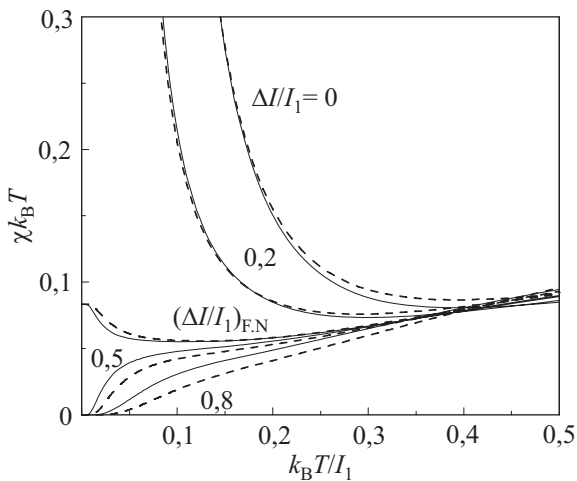


Рис. 7. Умноженная на температуру магнитная восприимчивость в нулевом поле в зависимости от температуры. Сплошными линиями изображены результаты $\tilde{U} = 0$ и $\tilde{t} = 0,375$, которые совпадают с соответствующими результатами работы [15]. Штриховыми линиями изображены результаты при $\tilde{U} = 55/12$ и $\tilde{t} = 1,0$.

максимумами (рис. 9). Возникновение ближайшего к нулю температуры дополнительного максимума теплоемкости (рис. 9) не связано с учетом отталкивания, так как имеет место также при $\tilde{U} = 0$. Этот максимум возникает, когда параметр $\tilde{\Delta I}$ попадает в достаточно маленькую окрестность критической точки $\tilde{\Delta I}_{F,N}$. Если проходить эту окрестность из основного состояния FRI, то второстепенный максимум теплоемкости разделяется на два максимума. При дальнейшем приближении к критической точке $\tilde{\Delta I}_{F,N}$ отвечающий меньшей температуре максимум быстро приближается к нулю температуры и в критической точке исчезает (рис. 9,а). За критической точкой в состоянии NAF он появляется снова возле нуля температуры. При отдалении от критической точки он быстро приближается к другому низкотемпературному максимуму и сливается с ним (рис. 9,б). Из изложенного выше следует, что именно исчезающий в критической точке $\tilde{\Delta I}_{F,N}$ максимум связан с тепловыми возбуждениями, которые отвечают за переходы между состояниями FRI и NAF. А неисчезающий в критической точке $\tilde{\Delta I}_{F,N}$ низкотемпературный максимум связан с тепловыми возбуждениями, которые отвечают за переходы между состояниями FRI и UPA и состояниями NAF и UPA.

4. Заключение

Для искаженной ромбической цепочки Изинга-Хаббарда с учетом одноцентрового кулоновского отталкивания методом декорационно-итерационного преобразования точно рассчитаны термодинамические характеристики: свободная энергия, энтропия, теплоемкость, намагниченность изинговской и электронной подсистем, магнитная восприимчивость. В случае антиферромагнитного взаимодействия Изинга,

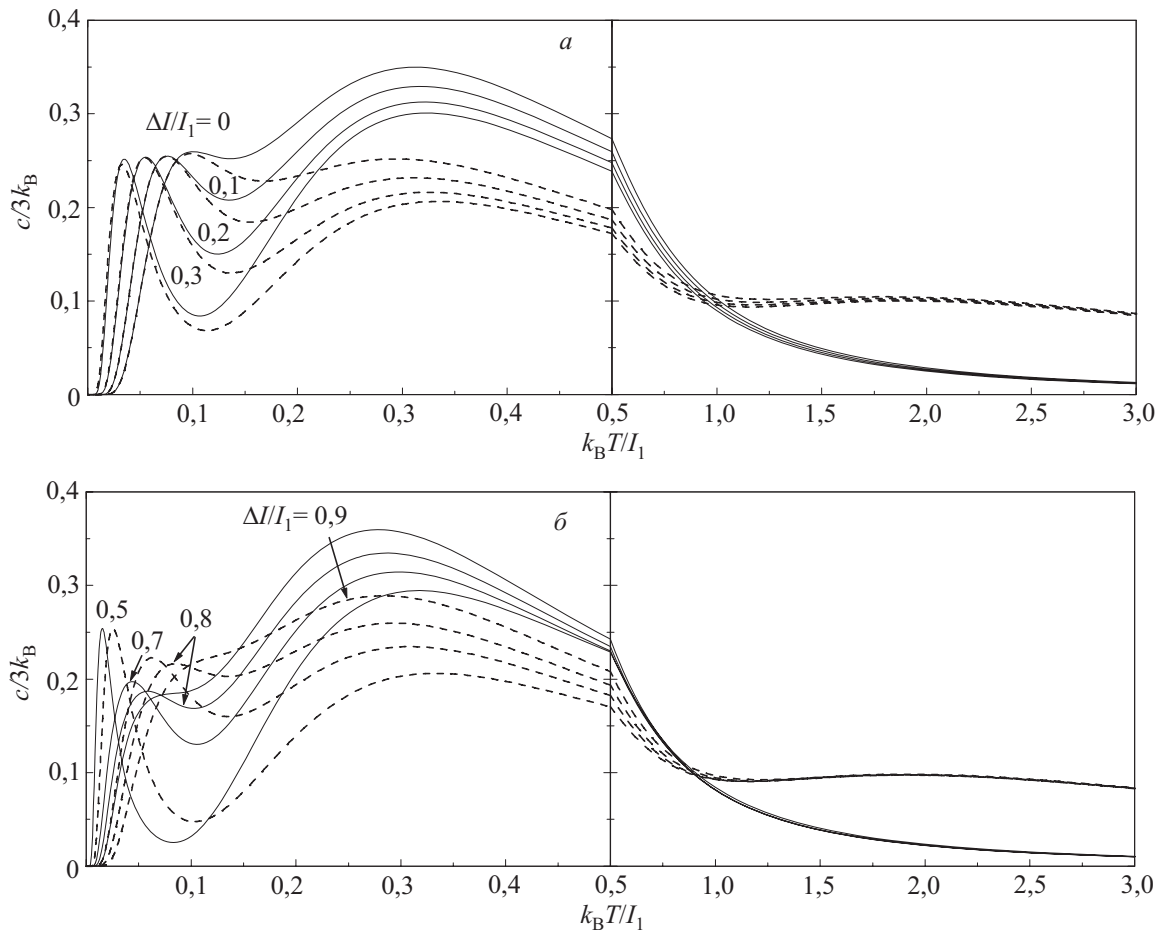


Рис. 8. Теплоемкость в нулевом поле в зависимости от температуры для двух случаев: FRI является основным состоянием (а) и NAF является основным состоянием (б). Сплошными линиями изображены результаты при $\tilde{U} = 0$ и $\tilde{i} = 0,375$, которые совпадают с соответствующими результатами работы [15]. Штриховыми линиями изображены результаты при $\tilde{U} = 55/12$ и $\tilde{i} = 1,0$.

когда система геометрически фрустрированная, исследовано влияние кулоновского отталкивания на основное состояние и в режиме (5) на термодинамику: намагниченность в зависимости от поля и температуры, магнитную восприимчивость и теплоемкость в зависимости от температуры.

В системе с кулоновским отталкиванием реализуются такие же четыре основных состояния (SPA, FRI, UPA, NAF) и такие же три типичные фазовые диаграммы основного состояния $(\Delta\tilde{I}, \tilde{h})$, как в системе без кулоновского отталкивания [15]. Изменение отталкивания, которое сопровождается таким изменением интенсивности перескоков, чтобы энергия состояния UPA оставалась неизменной, не изменяет тип фазовой диаграммы основного состояния, а лишь смещает граничные линии области основного состояния NAF. Влияние отталкивания и перескоков на вид фазовой диаграммы $(\Delta\tilde{I}, \tilde{h})$ изображено диаграммой (\tilde{i}, \tilde{U}) . Таким образом, реализовано полное описание свойств основного состояния в зависимости от параметров модели. Установлено, что возрастание кулоновского от-

талкивания эффективно ослабляет влияние интенсивности перескоков на основное состояние.

Изучены свойства основного состояния на некоторых критических линиях и в критических точках фазовых диаграмм $(\Delta\tilde{I}, \tilde{h})$. На линии сосуществования состояний FRI и SPA и при $\tilde{i} > \sqrt{1+\tilde{U}}/2$ в точке $(0, 0)$ реализуется фрустрированное состояние. В точке $(\Delta\tilde{I}_{\text{F|U}}, 2 - \Delta\tilde{I}_{\text{F|U}})$, где заканчивается линия сосуществования состояний FRI и SPA, основное состояние отличается от фрустрированного из-за наличия линейной составляющей в температурных зависимостях параметров R и h_0 , которая определяет основное состояние изинговской подсистемы в случае $R = h_0 = 0$. Это состояние имеет остаточную энтропию $s_{\text{res}} = k_B \ln[(3 + \sqrt{5})/2]$, большую, нежели фрустрированное состояние. В точках $(\Delta\tilde{I}_{\text{F,N}}, 0)$ и $(\Delta\tilde{I}_{\text{F|U}}, \tilde{h}_{\text{F|N|U}})$ изинговские спины являются эффективно свободными, а состояние междуузельной пары электронов однозначно определяется состояниями соседних изинговских спинов. При совпадении этих точек в точке $(0, 0)$ изинговские спины уже не являются эффективно сво-

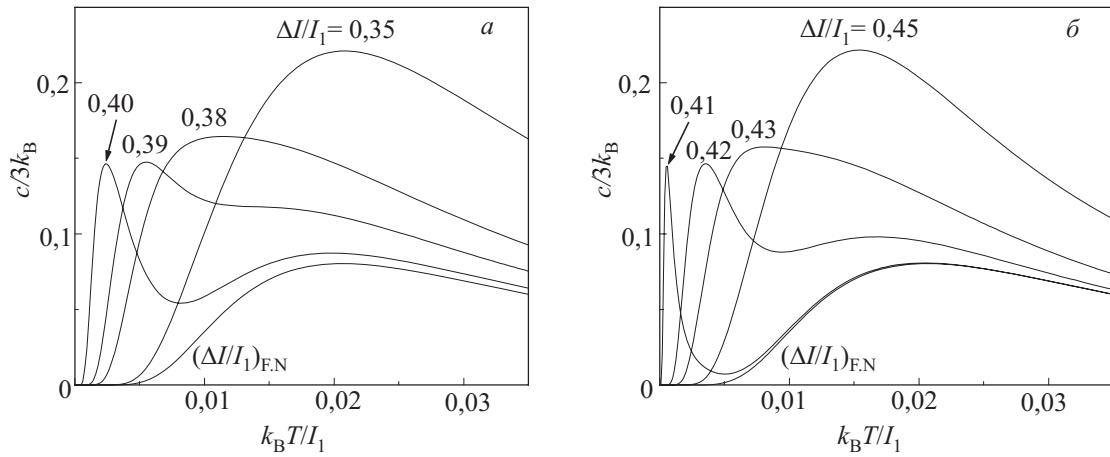


Рис. 9. Теплоемкость в нулевом поле в зависимости от температуры для $\tilde{t} = 1.0$ и $\tilde{U} = 55/12$ при разных $\tilde{\Delta I}$ из маленькой окрестности критической точки $\tilde{\Delta I}_{F.N.}$. Отображено приближение $\tilde{\Delta I}$ из области основного состояния FRI к критической точке $\tilde{\Delta I}_{F.N.}$ (а) и отдаление $\tilde{\Delta I}$ от критической точки $\tilde{\Delta I}_{F.N.}$ вглубь области основного состояния NAF (б).

бодными. Вместе с тем это основное состояние имеет наибольшую остаточную энтропию $s_{res} = k_B \ln 3$.

Влияние кулоновского отталкивания на процессы низкотемпературного намагничивания, низкотемпературные кривые намагниченности и магнитной восприимчивости ощутимо вблизи границы основного состояния NAF вследствие ее смещения. Высокотемпературные кривые намагниченности подсистем при возрастании кулоновского отталкивания смещаются противоположно: электронной подсистемы — к увеличению намагниченности, а изинговской подсистемы — к уменьшению намагниченности. При этом высокотемпературная кривая суммарной намагниченности смещается в область более высоких значений. Аналогично смещается высокотемпературная магнитная восприимчивость. Возрастание кулоновского отталкивания уменьшает высоту главного максимума теплоемкости, а при асимметрии изинговских взаимодействий из области основного состояния NAF перестраивает еще и второстепенный максимум теплоемкости. Сильное отталкивание предопределяет появление дополнительного максимума теплоемкости, который расположен значительно выше температуры главного максимума.

Обнаружено, что независимо от наличия кулоновского отталкивания теплоемкость в нулевом поле при попадании асимметрии изинговских взаимодействий в достаточно маленькую окрестность критической точки $\tilde{\Delta I}_{F.N.}$ имеет два низкотемпературных максимума. Ближайший к нулю температуры максимум исчезает в критической точке $\tilde{\Delta I}_{F.N.}$, то есть он связан с тепловыми возбуждениями, отвечающими за переходы между состояниями FRI и NAF.

Автор благодарен О.В. Держко и Т.М. Верхоляку за обсуждение и полезные замечания.

1. I. Syozi, *Prog. Theor. Phys.* **6**, 341 (1951).
2. M. Fisher, *Phys. Rev.* **113**, 969 (1959).
3. T. Kaneyoshi, *Prog. Theor. Phys.* **97**, 407 (1997).
4. V.R. Ohanyan and N.S. Ananikian, *Phys. Lett.* **A307**, 76 (2003).
5. J.S. Valverde, Onofre Rojas, and S.M. de Souza, *Physica* **A387**, 1947 (2008).
6. J. Strečka and M. Jaščur, *J. Phys.: Condens. Matter* **15**, 4519 (2003).
7. J. Strečka, M. Jaščur, M. Hagiwara, K. Minami, Y. Narumi, and K. Kindo, *Phys. Rev.* **B72**, 024459 (2005).
8. L. Čanová, J. Strečka, M. and Jaščur, *J. Phys.: Condens. Matter* **18**, 4967 (2006).
9. L. Čanová, J. Strečka, and T. Lučivjanský, *Condens. Matter Phys.* **12**, 353 (2009).
10. V. Ohanyan, *Condens. Matter Phys.* **12**, 343 (2009).
11. J.S. Valverde, Onofre Rojas, and S.M. de Souza, *J. Phys.: Condens. Matter* **20**, 345208 (2008).
12. D. Antonosyan, S. Bellucci, and V. Ohanyan, *Phys. Rev.* **B79**, 014432 (2009).
13. H. Kikuchi, Y. Fujii, M. Chiba, S. Mitsudo, T. Idehara, T. Tonegawa, K. Okamoto, T. Sakai, T. Kuwai, and H. Ohta, *Phys. Rev. Lett.* **94**, 227201 (2005).
14. H. Kikuchi, Y. Fujii, M. Chiba, S. Mitsudo, T. Idehara, T. Tonegawa, K. Okamoto, T. Sakai, T. Kuwai, and H. Ohta, *Prog. Theor. Phys. Suppl.* **159**, 1 (2005).
15. M.S.S. Pereira, F.A.B.F. de Moura, and M.L. Lyra, *Phys. Rev.* **B77**, 024402 (2008).
16. O. Derzhko, A. Honecker, and J. Richter, *Phys. Rev.* **B79**, 054403 (2009).
17. M.S.S. Pereira, F.A.B.F. de Moura, and M.L. Lyra, *Phys. Rev.* **B79**, 054427 (2009).
18. Р. Бэкстер, *Точно решаемые модели в статистической механике*, Мир, Москва (1985).
19. B. Lisnii, *Ukr. J. Phys.* **53**, 708 (2008).

Distorted diamond Ising–Hubbard chain

B.M. Lisnii

The ground state and the thermodynamics of a distorted diamond Ising-Hubbard chain are studied with taking into account the on-site Coulomb repulsion. Exact results for free energy, entropy, specific heat, magnetizations of Ising and Hubbard subsystems, and magnetic susceptibility are obtained by using the method of decoration-iteration transformation. In the case of geometric frustration the effect of Coulomb repulsion on ground state, field and temperature dependences of magnetization, magnetic susceptibility, spe-

cific heat is analyzed. Strong repulsion gives rise to an additional high-temperature maximum of the specific heat. Despite of presence of the repulsion, the specific heat may have two low-temperature peaks.

PACS: 75.10.Pq Spin chain models;
75.40.Cx Static properties;
75.50.Gg Ferrimagnetics;
75.10.Jm Quantized spin models, including quantum spin frustration.

Keywords: spin-electron chain, exactly solvable model, geometric frustration, ground state, magnetization plateau, specific heat.